

CLIPPEDIMAGE= JP407263408A

PAT-NO: JP407263408A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07263408 A

TITLE: PLASMA ETCHING METHOD

PUBN-DATE: October 13, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWATA, MAKOTO

YAKUSHIJI, MAMORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP06046817

APPL-DATE: March 17, 1994

INT-CL (IPC): H01L021/3065;C23F004/00 ;H01L021/304

ABSTRACT:

PURPOSE: To avoid the fluctuation in the residual underneath film for assuring an excellent wafer-to-wafer uniformity by a method wherein the etching step is to be started after cleaning and seasoning steps using HCl, BCl₃ gas plasma as well as preetching step using an etching gas plasma.

CONSTITUTION: A cleaning gas (SF₆), a seasoning gas (BCl₃) and an etching gas (Cl₂ gas) fed from a feeder 8 by a magnetic field and microwave electric field formed by DC fed from a magnetic field generating DC current 5 to solenoid coils 6, 7 are to be made plasmatic. Next, a preprocessing chamber 4 is cleaned up using cleaning gas (SF₆) plasma while the seasoning and preetching steps of the processing chamber are performed using the seasoning gas (BCl₃ gas plasma) and the etching gas plasma (Cl₂). At this time, a wafer 10 mounted on a mounting electrode 9 is etched away using the etching gas (Cl₂). Through these procedures, the effect of residual fluorine after the cleaning step is averted thereby enabling the fluctuation in the etching rate of Si and an oxide film to be avoided.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

DERWENT-ACC-NO: 1995-387417
DERWENT-WEEK: 199550
COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Plasma etching method for cleaning semiconductor wafer - comprises etching with plasma gas contg. fluorine, treating with mixed gas plasma using e.g. hydrogen chloride and boron tri:fluoride gas, etc..

PATENT-ASSIGNEE: HITACHI LTD[HITA]

PRIORITY-DATA: 1994JP-0046817 (March 17, 1994)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 07263408 A	October 13, 1995	N/A	004	H01L 021/3065

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP07263408A	N/A	1994JP-0046817	March 17, 1994

INT-CL (IPC): C23F004/00; H01L021/304 ; H01L021/3065

ABSTRACTED-PUB-NO: JP07263408A

BASIC-ABSTRACT: Si or polycrystalline-Si or silicide is cleaned by etching using plasma gas contg. F, seasoning treated with mixed gas plasma using HCl gas of BF3 gas or mixed gas of at least 2 selected from HCl, BF3, Cl2 and pre-etching treated by plasma contg. etching gas of Cl or mixed gas of Cl2 and O2, and then etched by Cl gas or mixed gas of Cl2 and O2.

USE - The method is suitable for cleaning of semiconductor wafer.

ADVANTAGE - Variation of etching speed on Si and oxide film is prevented by restraining effect of remaining F after cleaning.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/7

TITLE-TERMS:

PLASMA ETCH METHOD CLEAN SEMICONDUCTOR WAFER COMPRISE ETCH PLASMA
GAS CONTAIN
FLUORINE TREAT MIX GAS PLASMA HYDROGEN CHLORIDE BORON TRI FLUORIDE GAS

DERWENT-CLASS: L03 U11

CPI-CODES: L04-C07D;

EPI-CODES: U11-A10; U11-C07A1; U11-C07C1; U11-C07C2;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1666P; 1666U ; 1699U ; 1704U ; 1779U ;
1781U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1995-166763

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1995-283142

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-263408

(43) 公開日 平成7年(1995)10月13日

(51) Int.Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01L 21/3065				
C23F 4/00		E 8417-4K		
H01L 21/304	341 D			
			H01L 21/302	N
				F
			審査請求 未請求 請求項の数3	OL (全4頁)

(21) 出願番号	特願平6-46817	(71) 出願人	000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
(22) 出願日	平成6年(1994)3月17日	(72) 発明者	縄田 誠 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内
		(72) 発明者	葉師寺 守 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内
		(74) 代理人	弁理士 小川 勝男

(54) 【発明の名称】 プラズマエッチング方法

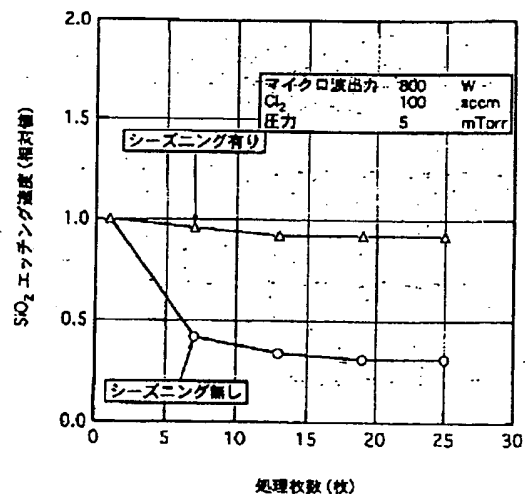
(57) 【要約】

【目的】クリーニング後のシリコン及び下地膜である酸化膜 (SiO_2) のエッチング速度の変化を抑制しウエハ間の均一性を向上させるのに好適なプラズマエッチング方法を提供することにある。

【構成】クリーニング後 HCl あるいは BCl_3 ガスプラズマと Cl_2 あるいは Cl_2 と O_2 の混合ガスプラズマでシーズニング並びにプレエッチングを行い、クリーニング後の処理室 (4) 内の残留物の影響を減少させる。

【効果】クリーニング後の残留フッ素の影響を抑制しシリコン及び酸化膜のエッチング速度の変動を防止することができる。

図 6



【特許請求の範囲】

【請求項1】フッ素を含むガスプラズマによりクリーニングを行い、クリーニング後、塩素ガスの単独ガスあるいは塩素ガスと酸素ガスとの混合ガスをエッチングガスとして用いてシリコン、多結晶シリコン、シリサイドのエッチングを行うエッチング装置において、前記クリーニング後に塩化水素ガス、三氟化硼素ガスの単独ガスあるいは塩化水素ガス、三氟化硼素ガス、塩素ガスの少なくとも2種類以上の混合ガスのプラズマによるシーズニングとエッチングガスのプラズマによるプレエッチングを行った後エッチングを開始することを特徴とするプラズマエッチング方法。

【請求項2】前記フッ素を含むガスが六フッ化硫黄、三フッ化窒素、二フッ化キセノン、フッ素、三フッ化塩素の単独ガスあるいは混合ガスであることを特徴とする請求項1記載のプラズマエッチング方法。

【請求項3】前記シーズニングにおいてSiFの発光スペクトルをモニターし発光スペクトルの強度の時間変化が一定値以下になった時点でシーズニングを終了しエッチングを開始することを特徴とする請求項1記載のプラズマエッチング方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、フッ素を含むガスプラズマによりクリーニングを行うものに係り、特に、クリーニング後のシリコン及び下地膜である酸化膜(SiO₂)のエッチング速度の変化を抑制しウエハ間の均一性を向上させるのに好適なプラズマエッチング方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、エッチングを含めたプラズマプロセスではウエハの粒子汚染を防止するためにクリーニングを行いクリーニング後の処理室内の残留物をなくすためにポストクリーニングを行っている。SF₆、NF₃ガスをクリーニングに用いた場合にはN₂、Ar、H₂、O₂ガスプラズマがポストクリーニングに用いられている。

【0003】なお、本技術に関するものとして、例えば、文献：平塚豊著、洗浄設計P41-53、1992、Summerが挙げられる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】従来のエッチング方法では、クリーニング後の処理室内の残留物のエッチング特性に及ぼす影響について考慮されておらず、クリーニング後処理枚数とともにシリコン及び下地膜の酸化膜のエッチング速度が減少し、下地酸化膜の残膜が変動するという問題点があった。

【0005】本発明は、クリーニング後のシリコン及び酸化膜のエッチング速度の減少を抑制し下地酸化膜の残膜の変動を防止し良好なウエハ間の均一性が得られるエ

ッチング方法を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記目的を解決するために、クリーニング後HCl、BCl₃ガスプラズマによるシーズニングとエッチングガスであるCl₂あるいはCl₂とO₂の混合ガスプラズマによるプレエッチングを行い、クリーニング後の処理室内の残留物の影響を減少させようとしたものである。

【0007】

10 【作用】図1に、SF₆ガスプラズマでクリーニングを行った後、Cl₂ガスプラズマでシリコンをエッチングした場合におけるSiF(波長441nm)の発光スペクトルの処理枚数による変化を示す。シリコンとフッ素の反応によって生成するSiFの発光スペクトルの強度は処理枚数とともに減少しほぼ一定となる。このことからフッ素を含むガスによるクリーニング後、処理室内にはフッ素が残留していることが分かった。図2、図3に、Cl₂ガスにSF₆ガスを添加した場合のSiFの発光スペクトルとシリコン及び酸化膜のエッチング速度の変化を示す。図2、図3に示すようにSF₆の添加量の増加とともにシリコン及び酸化膜のエッチング速度は増加する。また、SF₆の添加量の増加とともにSiF(波長441nm)の発光スペクトルの強度は増加する。このことから残留フッ素によりシリコン及び酸化膜のエッチング速度は変動し、残留フッ素の減少とともにシリコン及び酸化膜のエッチング速度が低下することを見出した。したがって、クリーニングの後残留フッ素の除去のためHCl、BCl₃ガスプラズマによるシーズ

【0008】

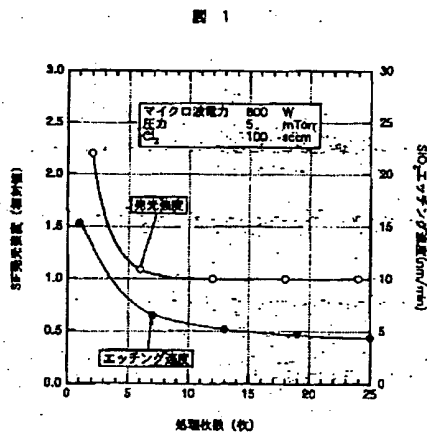
40 【実施例】本発明の一実施例を図5により説明する。図5は、マイクロ波プラズマエッチング装置の概略図を示したものである。図5において、マグネトロン1から発振したマイクロ波は導波管2を伝播しマイクロ波導入窓3を介して処理室4に導かれる。磁界発生用直流電源5からソレノイドコイル6、7に供給される直流電流によって形成される磁界とマイクロ波電界によってエッチングガス供給装置8から供給されるクリーニングガス(SF₆)、シーズニングガス(BCl₃)及びエッチングガス(Cl₂ガス)はプラズマ化される。SF₆ガスプラズマにより処理室4のクリーニングが行われる。処理室4

のシーズニング及びアレエッチングが、 BCl_3 ガスプラズマと Cl_2 ガスプラズマにより行われる。 Cl_2 ガスにより載置電極9に載置されているウエハ10がエッチングされる。クリーニング、エッチング時の圧力は真空排気装置11によって制御される。また、ウエハに入射するイオンのエネルギーは載置電極9に高周波電源12から供給される高周波電力によって制御される。図6、図7にシーズニングの有無によるシリコン及び酸化膜のエッチング速度の変化の違いを示す。シーズニング及びアレエッチングは BCl_3 ガスプラズマと Cl_2 ガスプラズマにより行い、SiFの発光スペクトルを10秒毎にモニタし時間 t_n と時間 t_{n-1} に測定したスペクトルの発光強度比が 1 ± 0.002 になった時点でシーズニングを停止した。クリーニング後にシーズニングを行うことによりクリーニング時に生成されるフッ素の残留の影響を抑制しエッチング速度の変動を防止できる。

【0009】本一実施例によれば、クリーニング後の残留フッ素の影響を抑制しシリコン及び酸化膜のエッチング速度の変動を防止することができる。

【0010】本一実施例ではマイクロ波プラズマエッチング装置についてその効果を説明したが、他の放電方式例えば反応性イオンエッチング(RIE)、プラズマモードエッチング(PE)、マグネトロンRIE、ヘリコン、TCPにおいても同様な効果が得られる。

【図1】



【0011】

【発明の効果】本発明によれば、クリーニング後の残留フッ素の影響を抑制しシリコン及び酸化膜のエッチング速度の変動を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】SiF発光強度の処理枚数依存性示す説明図である。

【図2】SiF発光強度の SF_6 添加量依存性を示す説明図である。

10 【図3】Si及び SiO_2 エッチング速度の SF_6 添加量依存性を示す説明図である。

【図4】SiF発光強度の処理時間依存性示す説明図である。

【図5】マイクロ波プラズマエッチング装置の構成図である。

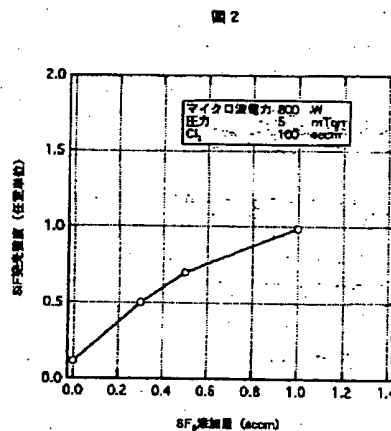
【図6】本発明の一実施例での効果を説明するための SiO_2 エッチング速度の処理枚数依存性示す説明図である。

【図7】本発明の一実施例での効果を説明するためのSiエッチング速度の処理枚数依存性示す説明図である。

【符号の説明】

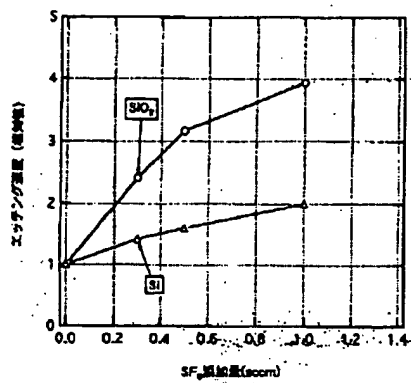
2...導波管、3...マイクロ波導入窓、4...処理室、6...ソレノイドコイル。

【図2】



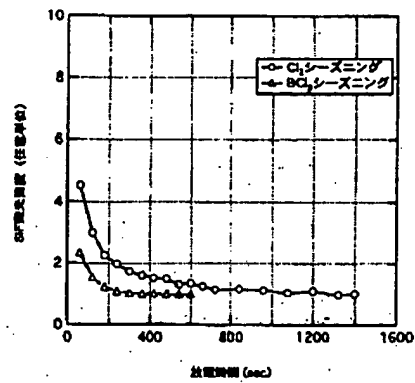
【図3】

図 3



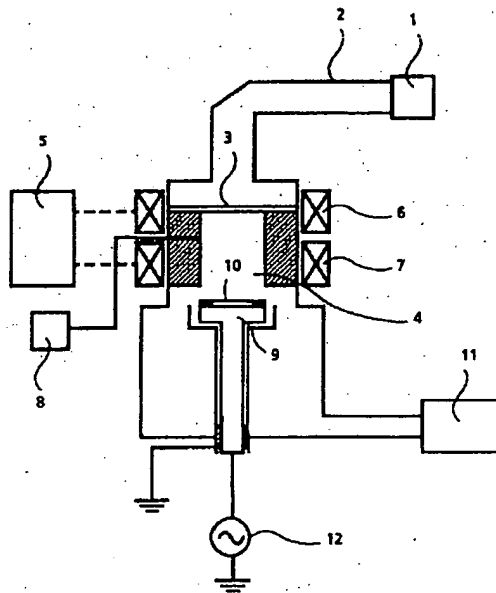
【図4】

図 4



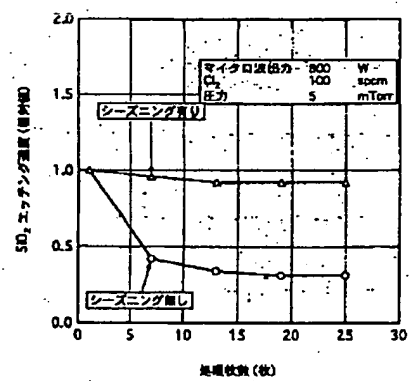
【図5】

図 5



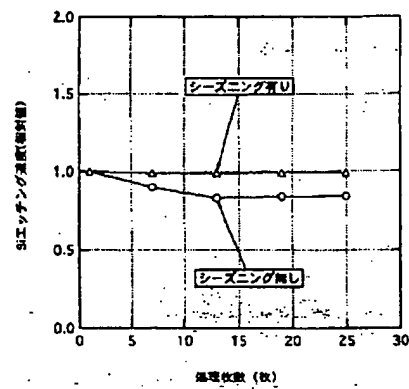
【図6】

図 6



【図7】

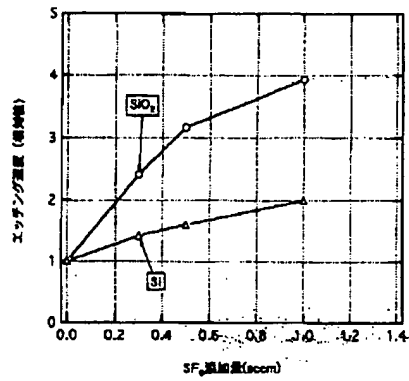
図 7



THIS PAGE BLANK (USPTO)

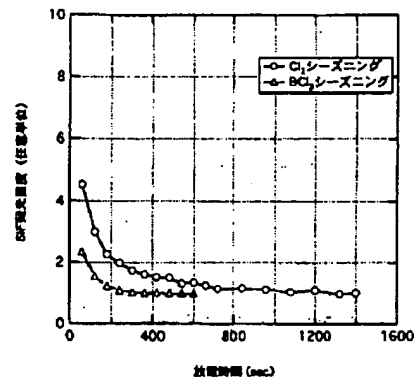
【図3】

図 3



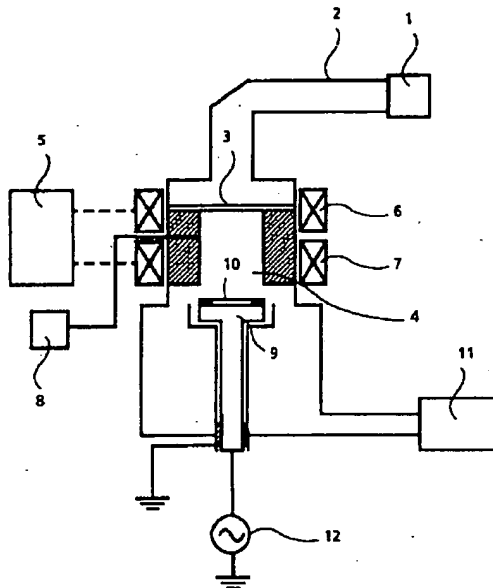
【図4】

図 4



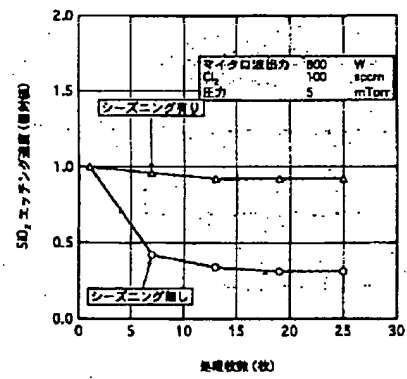
【図5】

図 5



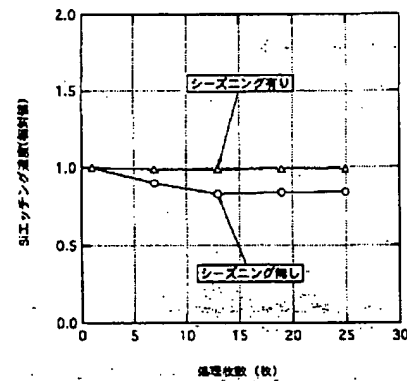
【図6】

図 6



【図7】

図 7



THIS PAGE BLANK (USPTO)